

学位論文公聴会

午前
日時： 2 月 15 日 (火) 1 時 0 0 分 ~ 3 時 0 0 分

午後

場所： オンライン開催 (<https://kyoto-u-edu.zoom.us/j/82418522828?pwd=ZVNpWjQ1NWkwclZCQVpSbXVlSCt0dz09>)

講演者：工学研究科電子工学専攻

鐘ヶ江 一孝

論文題目：

Growth and Process-Induced Deep Levels in Wide Bandgap Semiconductor GaN and SiC

(結晶成長及びプロセスにより導入されるワイドバンドギャップ半導体 GaN 及び SiC 中の深い準位)